

Перв. примен.		Справ. N		Подп. и дата		Инв. N дубл.		Взам. инв. N		Подп. и дата		Инв. Nподл.	
РЕУН.94.16.13.002													
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание							
				<u>Документация</u>									
A2			РЕУН.468332.001 СБ	Сборочный чертеж									
*)			РЕУН.468332.001 ЗЗ	Схема электрическая		*)А3,А4							
				принципиальная									
A4			РЕУН.468332.001 ПЭЗ	Перечень элементов									
*)			РЕУН.468332.001 ВП	Ведомость покупных изделий		*)А3,А4							
				<u>Сборочные единицы</u>									
A4	2		РЕУН.687253.002	Плата печатная	1								
				<u>Прочие изделия</u>									
				Конденсаторы фирма Kemet,США									
		6		С1210С475К5РАСТU	3	С22,С25, С26							
		8		С1210С476М4РАСТU	2	С36, С38							

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		10		Конденсатор 08055D105KAT2A	2	С28, С31
				фирма Куосега AVX, США		
				Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
		13		СС0603KRX7R7BB105	8	С9-С14, С17,
						С39
		15		СС0603KRX7R9BB102	1	С23
		17		СС0603KRX7R9BB472	1	С30
		19		СС0603KRX7R9BB103	1	С27
		21		СС0603KRX7R9BB333	1	С33
		23		СС0603KRX7R9BB104	13	С1-С7, С15,
						С16, С19, С21,
						С29, С35
		25		СС0603KRX7R9BB105	4	С18, С24, С34,
						С37

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕУН.468332.001

Лист
2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань		
		28		CC0603ZRY5V9BB224	1	С32
		30		CC1206KKX5R8BB106	1	С8
				Конденсаторы фирма Panasonic, Япония		
		33		EEE-FP1A221AP	1	С40
		35		EEHZC1H101P	1	С20
		37		Микросхема K7805-500R3	1	DA1
				фирма Mornsun Power, Китай		
		39		Микросхема LT3741EFE#PBF	1	DA7
				фирма Analog Devices, США		
		41		Микросхема LMV321DBVT	4	DA3,DA4,
				фирма Texas Instruments, США		DA6,DA8
		43		Микросхема TC4427COA	2	DA5,DA9
				фирма Microchip, США		

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468332.001	Лист
						3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		45		Микросхема TLV70233DBVT	1	DA2
				фирма Texas Instruments, США		
		47		Микросхема MAX232ID	1	DD2
				фирма Texas Instruments, США		
		49		Микроконтроллер STM32F030C8T6	1	DD1
				фирма ST Microelectronics, Малайзия		
				Светодиоды фирма Kingbright, Тайвань		
		52		APT1608CGCK	1	HL1
		53		APT1608EC	1	HL2
		55		Ферритовая дюсина BLM18TG102TN1D	1	L1
				фирма Murata Electronics, США		
		57		Катушка индуктивности 7443551130	1	L2
				фирма Wurth Elektronik, Германия		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468332.001	Лист
						4

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		59		RC0603FR-070RL	4	R5-R7,R32
		61		RC0603FR-0710RL	2	R21,R34,R35,
						R38
		63		RC0603FR-071KL	4	R2,R4,R11,
						R12
		65		RC0603FR-074K7L	1	R18
		67		RC0603FR-079K1L	1	R20
		69		RC0603FR-0710KL	11	R1,R8-R10,
						R13,R14,
						R16,R17,
						R24,R28,R33
		71		RC0603FR-0711KL	1	R19
		73		RC0603FR-0712KL	2	R31,R39

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕУН.468332.001

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		76		RC0603FR-0745K3L	1	R25
		78		RT0603DRD0765K5L	1	R30
		80		RC0603FR-07100KL	4	R3,R15,R27,
						R29
		82		RC0603FR-07120KL	1	R23
		84		RC0603FR-07360KL	1	R22
		86		RC0603FR-07680KL	1	R26
		88		Резистор CRCW2512100KFKEG	2	R36, R37
				фирма Vishay, США		
		90		Потенциометр 3224W-1-103E	1	RP1
				фирма Bourns, США		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468332.001	Лист
						6

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				фирма Diodes Incorporated, США		
		94		Стабилитрон BZT52C3V3S-7-F	2	VD2, VD5
		96		Диод 1N4148WS-7-F	4	VD7, VD8, VD11,
						VD12
		98		Диод PMEG6010CEH115	2	VD3, VD4
				фирма NXP Semiconductors, Кумау		
				Диоды фирма ON Semiconductor, США		
		101		MBRA340T3G	2	VD9, VD10
		103		SM05T1G	1	VD6
		105		Диод SMAJ24CA-E3/61	1	VD1
				фирма Vishay Semiconductors, США		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Транзисторы фирма Infineon		
				Technologies Corporation, Германия		
		62		BSC011N03LSI	5	VT6-VT10
		64		BSC080N03LS G	1	VT11
				Транзисторы фирма ON Semiconductor, США		
		67		FDD6637	2	VT1, VT2
		69		2N7002K	3	VT3-VT5
		71		Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S	1	X1
				фирма KLS Electronic, Кутаї		
				Вилки фирма Molex, США		
		74		47053-1000	1	X8
		76		87834-0819	1	X4

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕУН.468332.001

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Формат А4